



汕头华汕电子器件有限公司

A2

NPN SILICON TRANSISTOR

HM13003

对应国外型号
3DD13003

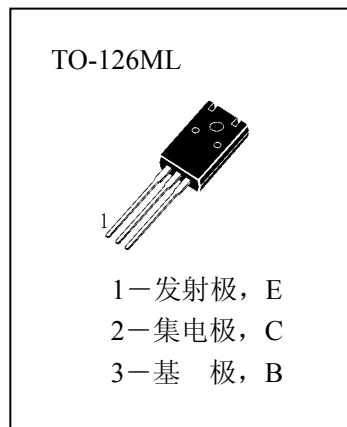
■ 主要用途

高压快速开关

■ 极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度	-65~150 $^\circ\text{C}$
T_j ——结温	150 $^\circ\text{C}$
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	40W
V_{CBO} ——集电极—基极电压	700V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压	400V
V_{EBO} ——发射极—基极电压	9V
I_C ——集电极电流 (DC)	1.5A
I_B ——基极电流	0.75A

■ 外形图及引脚排列



■ 电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	$I_C=5\text{mA}$, $I_B=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			10	μA	$V_{EB}=9\text{V}$, $I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	10		40		$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=0.5\text{A}$
$H_{FE}(2)$		5				$V_{CE}=2\text{V}$, $I_C=1\text{A}$
$V_{CE}(\text{sat})$	集电极—发射极饱和压降			0.5	V	$I_C=0.5\text{A}$, $I_B=0.1\text{A}$
				1	V	$I_C=1\text{A}$, $I_B=0.25\text{A}$
				3	V	$I_C=1.5\text{A}$, $I_B=0.5\text{A}$
$V_{BE}(\text{sat})$	基极—发射极饱和压降			1	V	$I_C=0.5\text{A}$, $I_B=0.1\text{A}$
				1.2	V	$I_C=1\text{A}$, $I_B=0.25\text{A}$
f_T	特征频率	4			MHz	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=0.1\text{A}$
t_{ON}	导通时间			1.1	μS	} $V_{CC}=125\text{V}$, $I_C=1\text{A}$ $I_{B1}=0.2\text{A}$, $I_{B2}=-0.2\text{A}$ $R_L=125\Omega$
t_{STG}	贮存时间			4.0	μS	
t_F	下降时间			0.7	μS	

■ 分档及其标志

H1	H2	H3	H4	H5
10-16	14-21	19-26	24-31	29-40